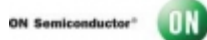


specificazioni	
Numero di parte	FDMS8880
fabbricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descrizione	MOSFET N-CH 30V 13.5A POWER56
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	103569 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.5V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (max) a Id, Vgs	8.5 mOhm @ 13.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	2.5W (Ta), 42W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1585pF @ 15V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	13.5A (Ta), 21A (Tc)

 FDMS8888 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-PQFN	 FDMS8888 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A 8-PQFN	 FDMS8D8N15C ON ON PQFN-8	 FDMS8880 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN
 FDMS8820 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56	 FDMS8888 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD DFN-85X6	 FDMS8820 MOS ON ON POWER56-8P	 FDMS8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 13.5A POWER56

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited